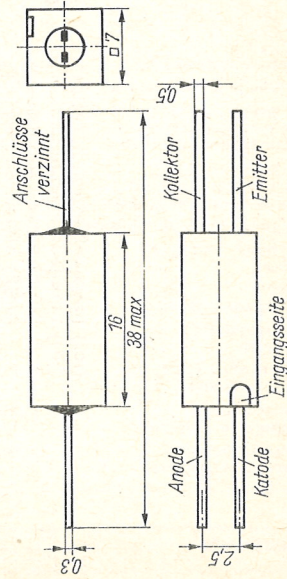


Optoelektronischer Koppler aus
GaAs-Lumineszenzdiode und Si-npn-Fototransistor
zur galvanischen Trennung von Stromkreisen
mit hohen Potentialdifferenzen.
Vorwiegend für den Einsatz in der
Steuer- und Regelungstechnik vorgesehen.



Grenzwerte bei $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$

Prüfspannung	U_p	$\pm 5\text{ kV}$
Eingangsdiode		
Durchlaßstrom	I_F	50 mA
Sperrgleichspannung	U_R	2 V
Ausgangstransistor		
Kollektor-Emitter-Spannung	U_{CE}	15 V
Emitter-Kollektor-Spannung	U_{EC}	5 V
Verlustleistung	P_{tot}	50 mW
Lagertemperatur	ϑ_{stg}	$-55 \dots 70^\circ\text{C}$
Betriebstemperatur	ϑ_a	$0 \dots 70^\circ\text{C}$

Kennwerte bei $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$

Kollektorstrom	bei $I_F = 0, U_{CE} = 15\text{ V}$ $I_F = 35\text{ mA}, U_{CE} = 5\text{ V}$	$0,1\text{ }\mu\text{A}$ $1,5\text{ mA}$
Kollektorspannung	bei $I_F = 35\text{ mA}, I_C = 200\text{ }\mu\text{A}$	$0,18\text{ V}$
Durchlaßspannung	bei $I_F = 35\text{ mA}$	$1,25\text{ V}$
Isolationswiderstand	bei $U_I = 1\text{ kV}$	10^{12} Ohm
Koppelkapazität		$0,35\text{ pF}$

Schaltzeiten

bei $I_C = 250\text{ }\mu\text{A}, U_B = 15\text{ V}, R_L = 1\text{ kOhm}$

Anstiegszeit	t_r	$5\text{ }\mu\text{s}$
Abfallzeit	t_f	$5\text{ }\mu\text{s}$
Verzögerungszeit	t_d	$3,5\text{ }\mu\text{s}$
Speicherzeit	t_s	$0,4\text{ }\mu\text{s}$